

	<h2 style="color: red;">NVD5867NLT4G-TB01</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVD5867NLT4G-TB01</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 22A DPAK DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVD5867NLT4G-TB01.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD5867NLT4G-TB01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 22A DPAK DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 43W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	675pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 6A (Ta), 22A (Tc) 3.3W (Ta), 43W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta), 22A (Tc)

NVD5867NLT4G-TB01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD5867NLT4G-TB01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD5867NLT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD5867NLT4G-TB01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD5867NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V DPAK</p>	 <p>NVD5867NL Ons NVD5867NL Ons</p>	 <p>NVD5890NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A DPAK</p>	 <p>NVD5890NT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 100A DPAK</p>
 <p>NVD5867NLT4G O O TO-252</p>	 <p>NVD5865NL Ons NVD5865NL Ons</p>	 <p>NVD5890NLT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 123A DPAK</p>	 <p>NVD5865NLT4G ON NVD5865NLT4G ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD5867NLT4G-TB01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD5867NLT4G-TB01 Datenblatt	NVD5867NLT4G-TB01-Datenblätter	NVD5867NLT4G-TB01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD5867NLT4G-TB01
NVD5867NLT4G-TB01 Electronic	NVD5867NLT4G-TB01-Komponenten	NVD5867NLT4G-TB01-Verteiler	NVD5867NLT4G-TB01-Bild	NVD5867NLT4G-TB01-Teil
NVD5867NLT4G-TB01 Preis	NVD5867NLT4G-TB01 Hersteller	NVD5867NLT4G-TB01 Bild	NVD5867NLT4G-TB01 Aktie	NVD5867NLT4G-TB01 Inventar
NVD5867NLT4G-TB01 Neu	NVD5867NLT4G-TB01 Original	NVD5867NLT4G-TB01 garantiert	NVD5867NLT4G-TB01 RFQ	NVD5867NLT4G-TB01 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited